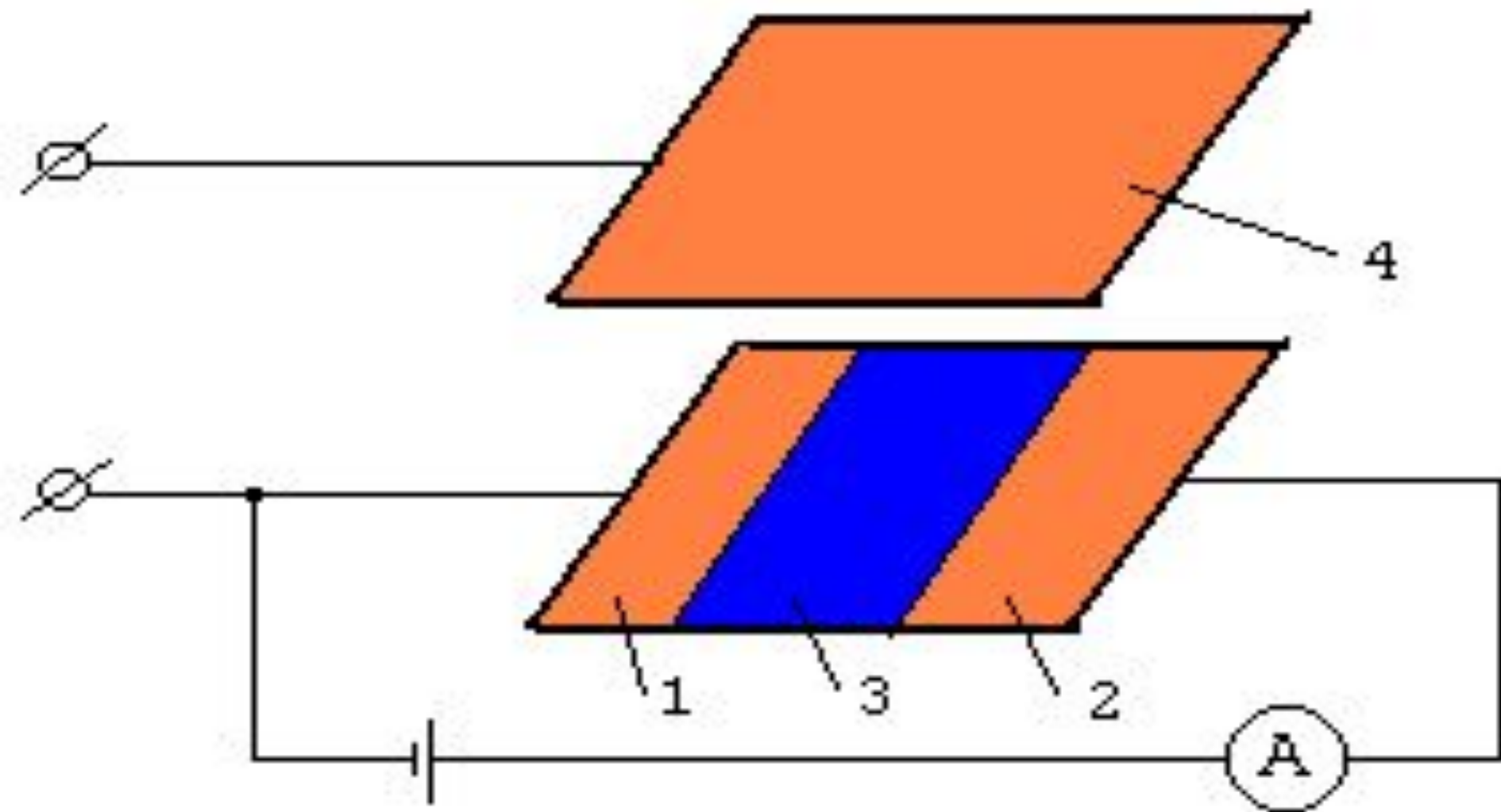


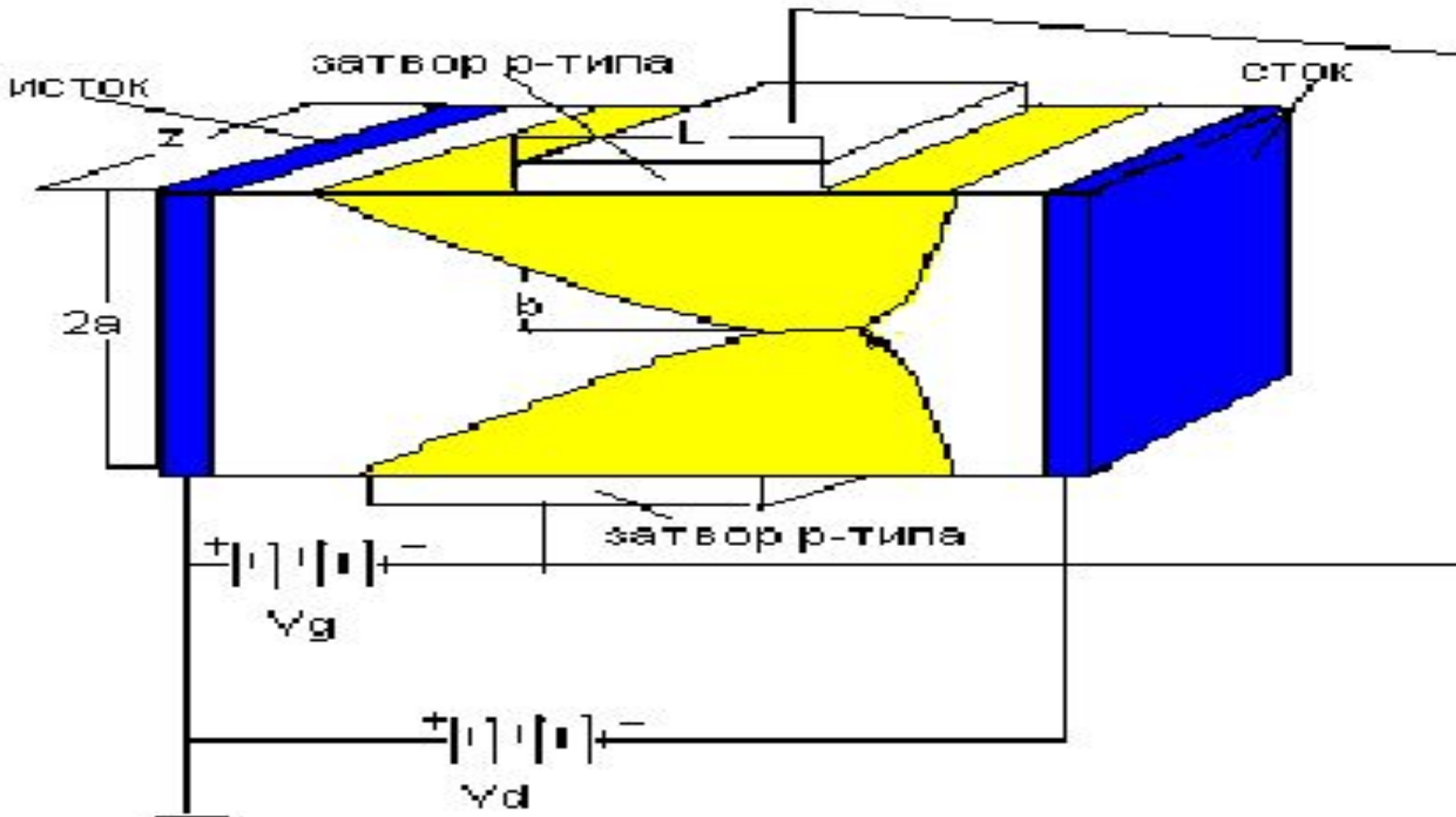
# Полевые транзисторы (иллюстрации).

Ночовнова А.Л. 21302

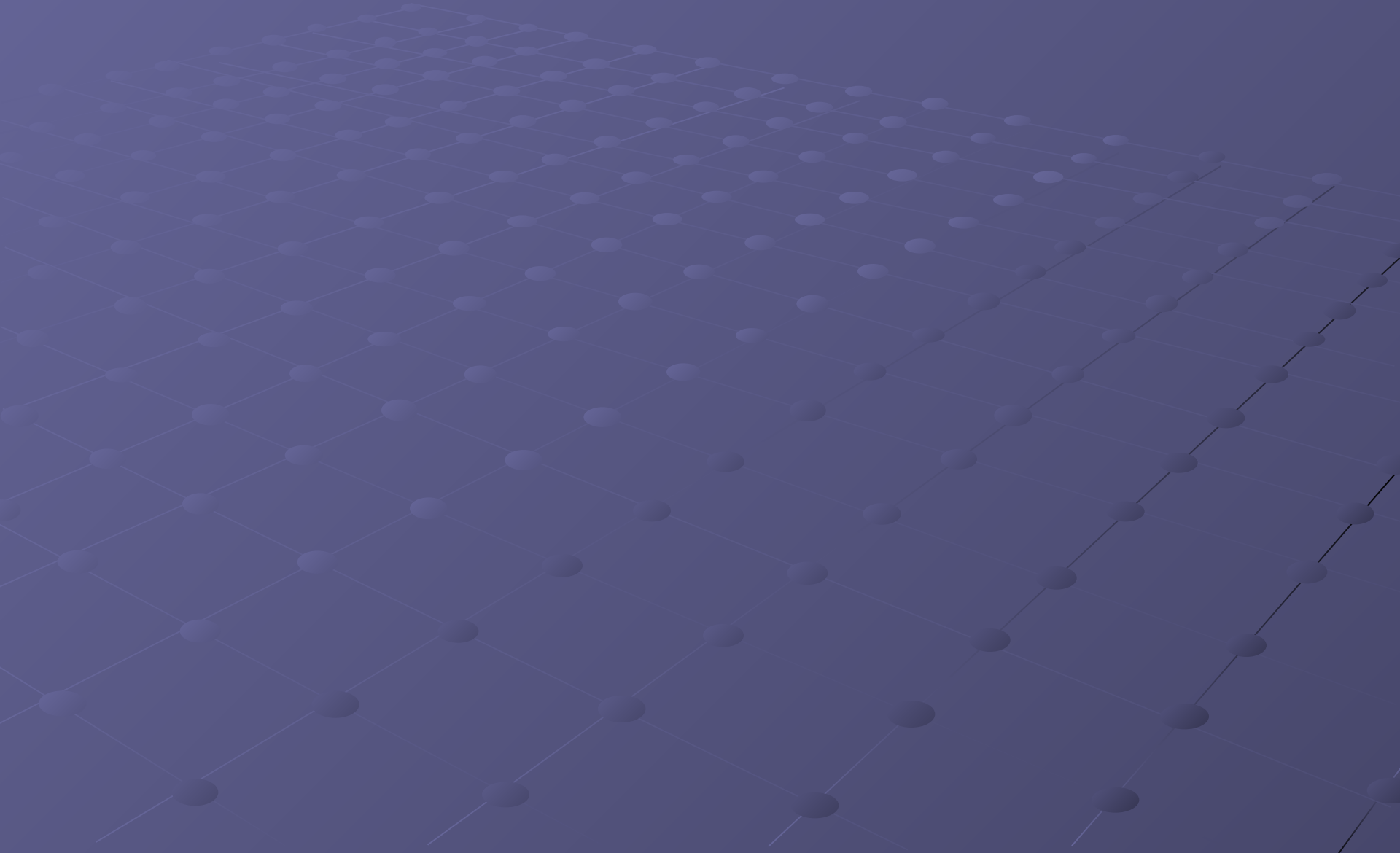
# Униполярный транзистор Хейла



# Схематичное изображение полевого транзистора согласно Шокли



# Принцип работы



# Стоковые характеристики

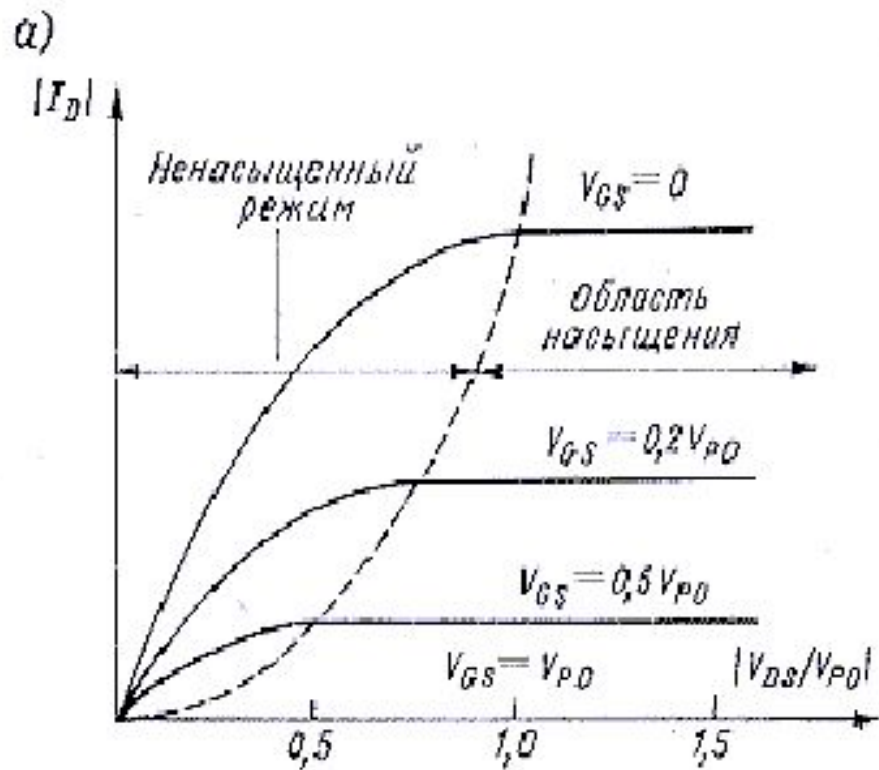
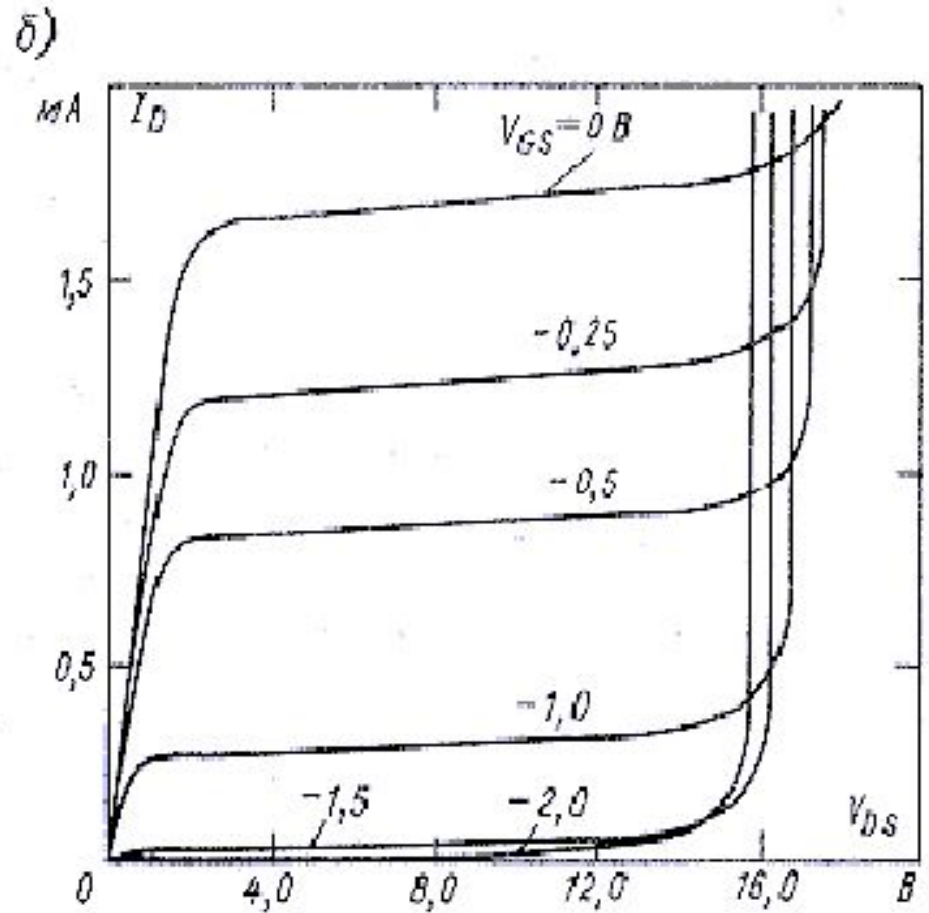
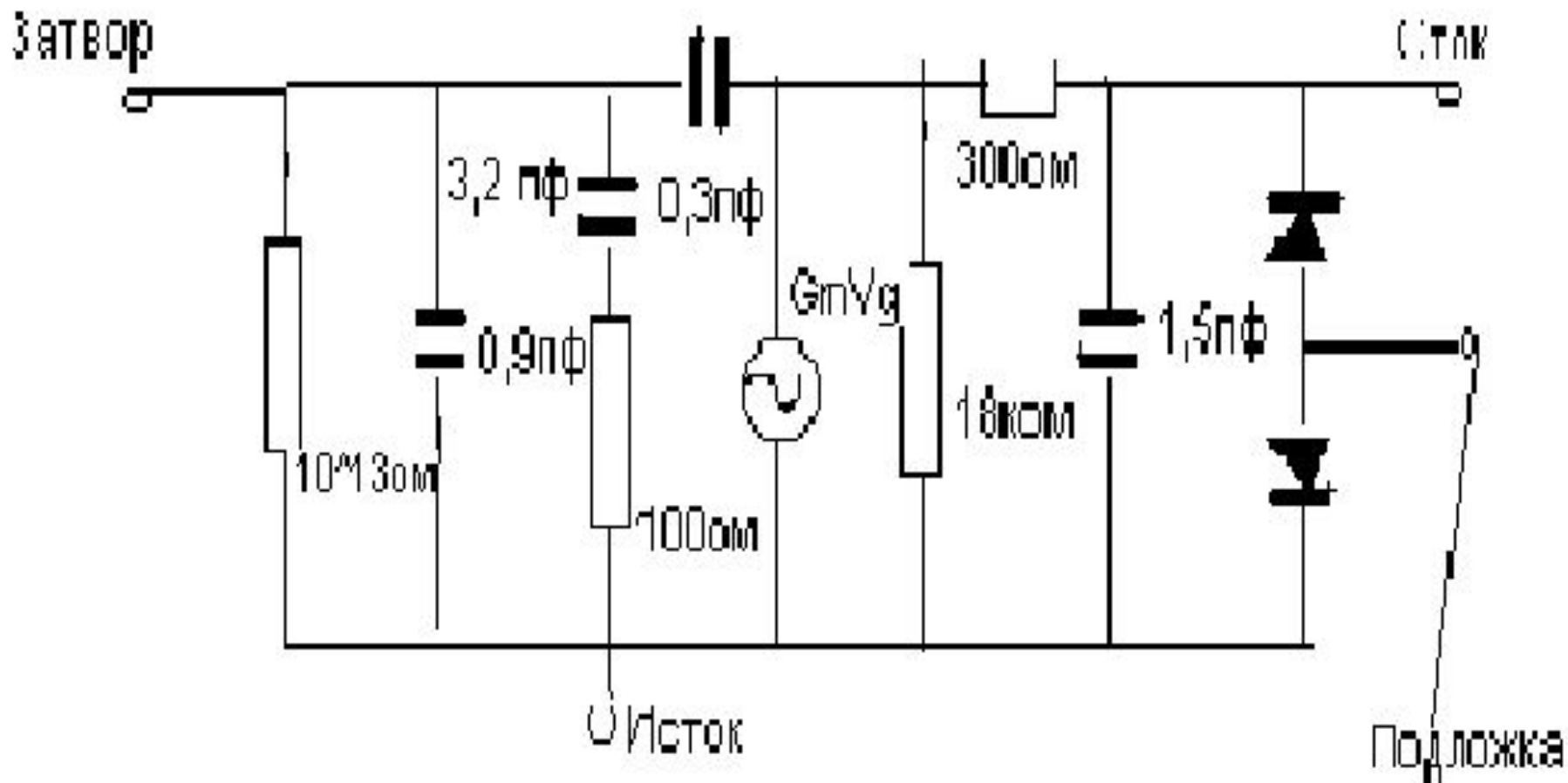


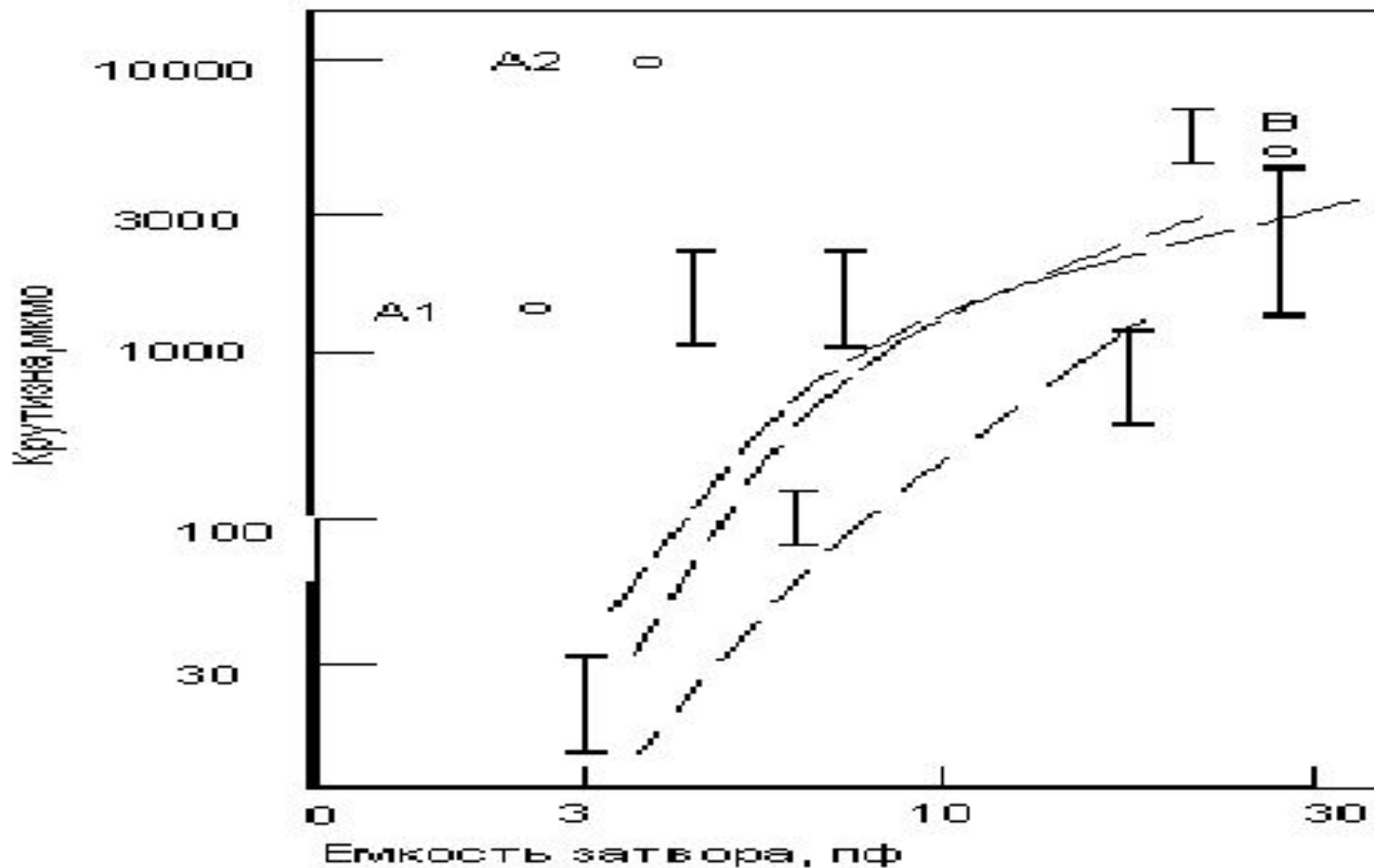
Рис. 2



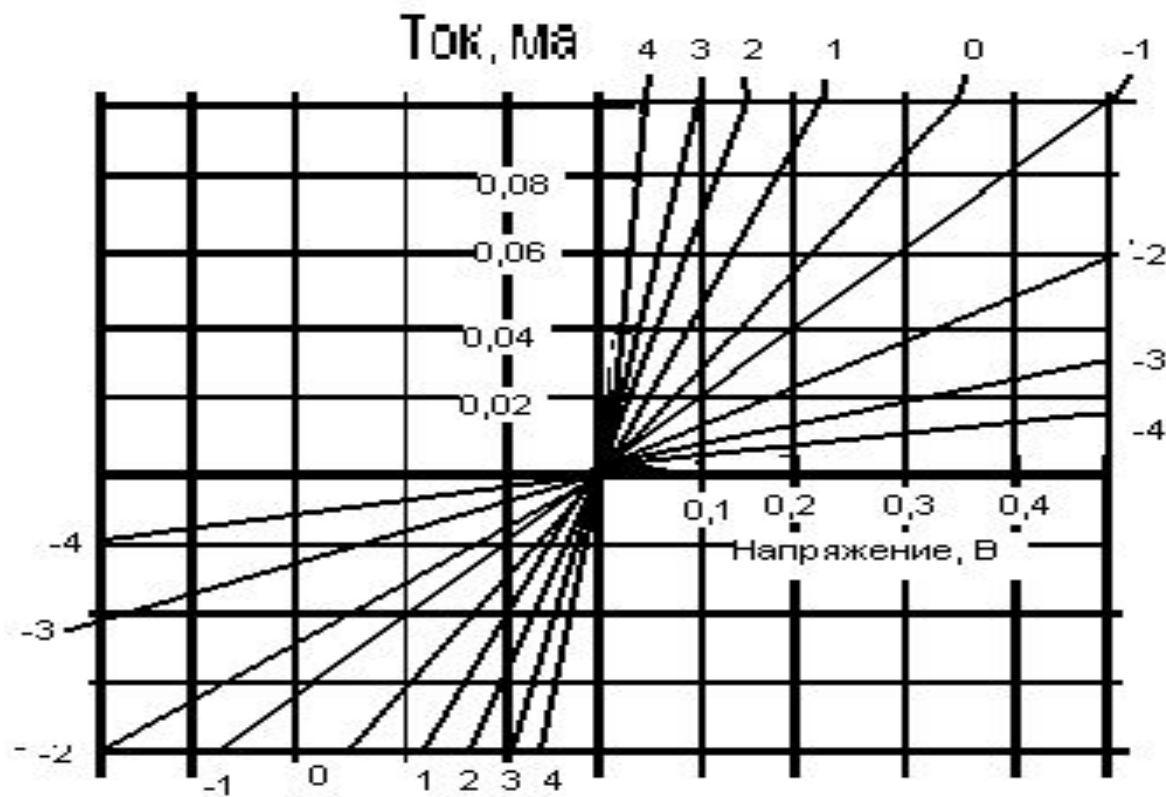
# Эквивалентная схема полевого транзистора с изолированным затвором



# Крутизна полевых транзисторов в зависимости от суммарной емкости затвора



# Зависимость тока стока от напряжения на стоке при различных напряжениях на затворе.



Зависимость тока стока от напряжения на стоке при различных напряжениях на затворе



# Полупроводниковые материалы пригодные для изготовления полевых транзисторов

Группа в периодической системе Менделеева	Полупроводниковый материал
I-V	Cs3Sb*
I-VI	Cu2O+
II-IV	Mg2Sn* Mg2Si*
II-VI	CdS+ CdTe* ZnO+ ZnS+ CdSe+
III-V	GaAs*+ GaSb* GaP*+ AlSb* InSb* InP*+ InAs*
IV	Ge*#+ Si*+ SiC*#
IV-VII	PbS*# PbSe* PbTe* TiO2+
V-VI	Bi2Te3*
VI	Te*
VI-VIII	NiO+

\*-возможность создания p-n перехода

+ - величина удельного сопротивления позволяет использовать данный полупроводник для создания униполярного транзистора

# - полупроводник с временем жизни носителей пригодным для биполярного транзистора

# Зависимость крутизны от температуры

